シングルインライン型
Single In-line Package

D30XBN20

200V 30A

特 長

- 薄型 SIP パッケージ
- SBD ブリッジ
- 低 V_F・低 I_R

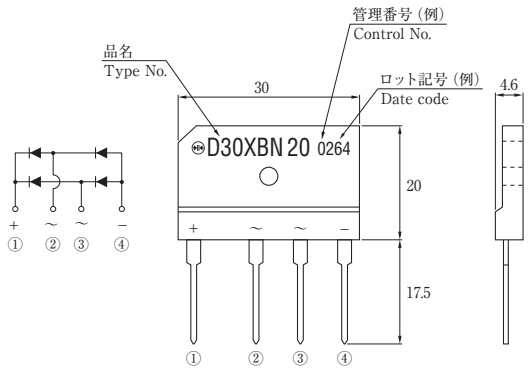
Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low V_F・Low I_R

■外観図 OUTLINE

Package：5S

Unit：mm
Weight：7.1g(typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合は Tc=25℃／unless otherwise specified）

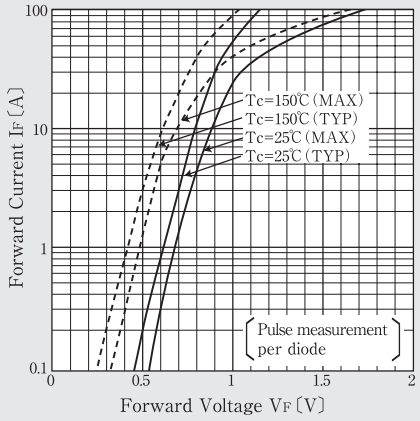
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions / 品名 Type No.		D30XBN20	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			−55～150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波，抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink Tc=91℃	30	A
			フィンなし Without heatsink Ta=26℃	3.1	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波，非繰り返し 1 サイクルせん頭値，Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃		350	A
絶縁耐圧 Dielectric Strenght	Vdis	一括端子・ケース間，AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	（推奨値：0.5 N・m） (Recommended torque : 0.5 N・m)		0.8	N・m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合は Tc=25℃／unless otherwise specified）

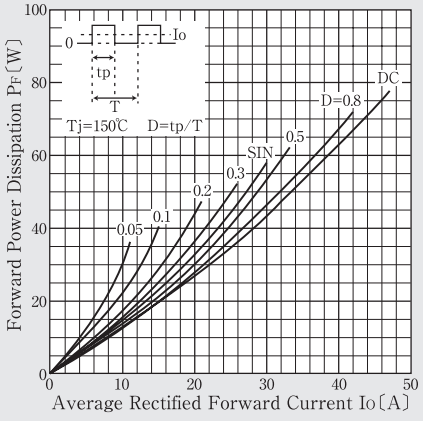
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F=15A, パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.90	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R=200V, パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f=1MHz, V_R=10V，1 素子当たりの規格値 per diode	TYP 360	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間，フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 1.0	℃/W
	θjl	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 5.0	
	θja	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 25	

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

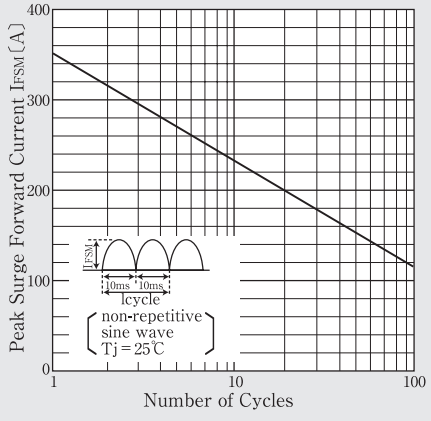
順方向特性
Forward Voltage



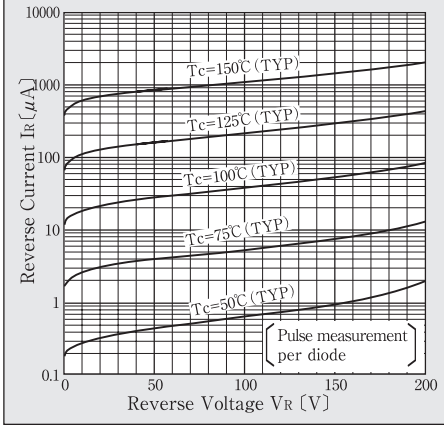
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



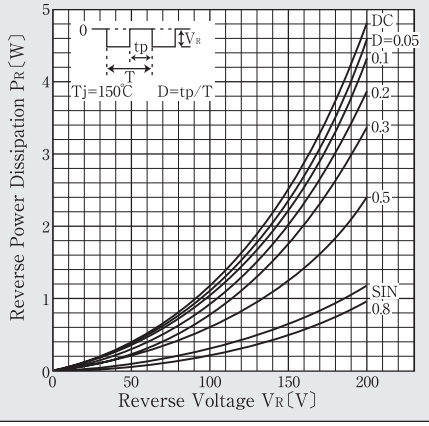
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



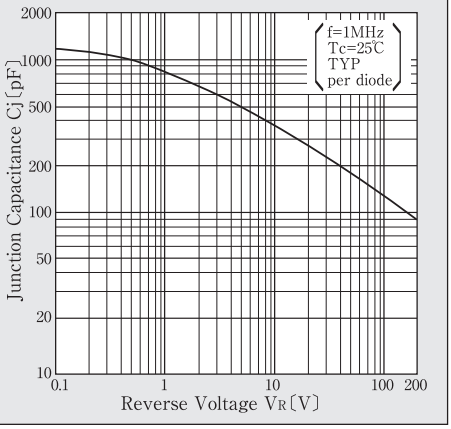
逆方向特性
Reverse Current



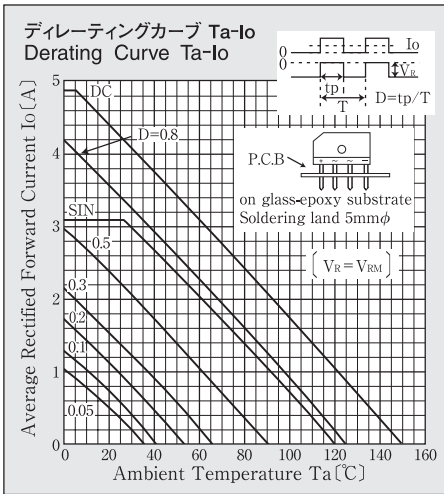
逆電力損失曲線
Reverse Power Dissipation



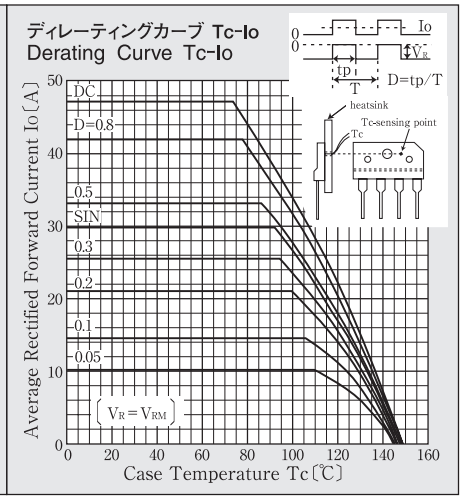
接合容量
Junction Capacitance



ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



＊ Sine wave は 50Hz で測定しています。
＊ 50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
＊ Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.